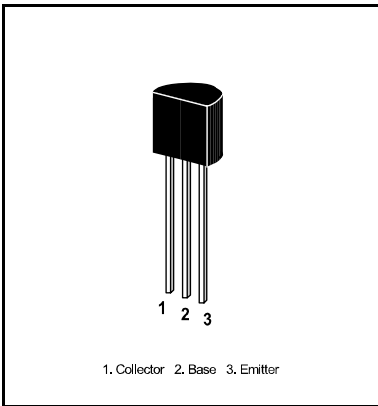


PNP Silicon Epitaxial Planar Transistors PNP



Power dissipation – Verlustleistung 625 mW
 Plastic case TO-92
 Kunststoffgehäuse (10D3)
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.18 g
 Plastic material has UL classification 94V-0
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
 Standard packaging taped in ammo pack see page 17
 Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack siehe Seite 17

Maximum ratings (T_A = 25°C)

Grenzwerte (T_A = 25°C)

		BC 327	BC 328
Collector-Emitter-voltage	- V _{CEO}	45 V	25 V
Collector-Emitter-voltage	- V _{CES}	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage	- V _{EBO}	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung	P _{tot}	625 mW ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom	- I _C	800 mA	
Peak Coll. current – Kollektor-Spitzenstrom	- I _{CM}	1 A	
Base current – Basisstrom	- I _B	100 mA	
Junction temp. – Sperrschichttemperatur	T _j	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _S	- 65...+ 150°C	

Characteristics, T_j = 25°C

Kennwerte, T_j = 25°C

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
- V _{CE} = 1 V, - I _C = 100 mA	Group -16	h _{FE}	100	160	250
	Group -25	h _{FE}	160	250	400
	Group -40	h _{FE}	250	400	630
- V _{CE} = 1 V, - I _C = 300 mA	Group -16	h _{FE}	60	130	–
	Group -25	h _{FE}	100	200	–
	Group -40	h _{FE}	170	320	–

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Kennwerte, $T_j = 25^\circ\text{C}$

	Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter cutoff current – Kollektorreststrom			
- $V_{CE} = 45\text{ V}$ BC 327 - I_{CES}	–	2 nA	100 nA
- $V_{CE} = 25\text{ V}$ BC 328 - I_{CES}	–	2 nA	100 nA
- $V_{CE} = 45\text{ V}, T_j = 125^\circ\text{C}$ BC 327 - I_{CES}	–	–	10 μA
- $V_{CE} = 25\text{ V}, T_j = 125^\circ\text{C}$ BC 328 - I_{CES}	–	–	10 μA
Collector-Emitter breakdown voltage			
Collector-Emitter Durchbruchspannung			
- $I_C = 10\text{ mA}$ BC 327 - $V_{(BR)CES}$	20 V	–	–
- $I_C = 10\text{ mA}$ BC 328 - $V_{(BR)CES}$	45 V	–	–
- $I_C = 0.1\text{ mA}$ BC 327 - $V_{(BR)CES}$	30 V	–	–
- $I_C = 0.1\text{ mA}$ BC 328 - $V_{(BR)CES}$	50 V	–	–
Emitter Base breakdown voltage			
Emitter-Basis-Durchbruchspannung			
- $I_E = 0.1\text{ mA}$ - $V_{(BR)EBO}$	5 V	–	–
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspg.			
- $I_C = 500\text{ mA}, I_B = -50\text{ mA}$ - V_{CEsat}	–	–	0.7 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung			
- $V_{CE} = 1\text{ V}, -I_C = 300\text{ mA}$ - V_{BE}	–	–	1.2 V
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz			
- $V_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 10\text{ mA}, f = 50\text{ MHz}$ f_T	–	100 MHz	–
Collector-Base Cap. – Kollektor-Basis-Kap.			
- $V_{CB} = 10\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ C_{CB0}	–	12 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air		R_{thA}	200 K/W ¹⁾
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			

Recommended complementary NPN transistors
Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren

BC 337 / BC 338
BC 337 / BC 338

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 2 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden